

	<b>DMNH10H028SCT</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	DMNH10H028SCT
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET BVDSS: 61V 100V,TO220-3,T
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMNH10H028SCT.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

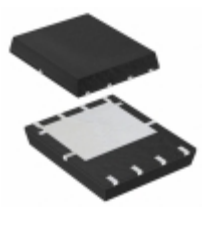





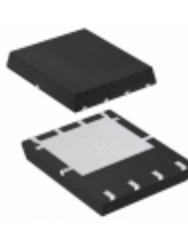

### Spezifikationen

Teilenummer	DMNH10H028SCT
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET BVDSS: 61V 100V,TO220-3,T
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	28 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1942pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31.9nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

DMNH10H028SCT Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMNH10H028SCT-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMNH10H028SCT Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMNH10H028SCT E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DMNH10H028SPSQ-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 40A POWERDI506</p>	 <p><b>DMNFR263FIB-KD</b> Panduit Corp CONN QC RCPT 14-16AWG 0.250</p>	 <p><b>DMNG1-63FL-3K</b> Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.250</p>	 <p><b>DMNH10H028SK3-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 55A TO252</p>
 <p><b>DMNH10H028SK3Q-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 55A TO252</p>	 <p><b>DMNFR163FIB-KD</b> Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.250</p>	 <p><b>DMNH10H028SPSQ-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 40A POWERDI506</p>	 <p><b>DMNFR1485FIB-KD</b> Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.187</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMNH10H028SCT Diodes Incorporated	DMNH10H028SCT Datenblatt	DMNH10H028SCT-Datenblätter	DMNH10H028SCT PDF	Diodes Incorporated DMNH10H028SCT
DMNH10H028SCT Electronic	DMNH10H028SCT-Komponenten	DMNH10H028SCT-Verteiler	DMNH10H028SCT-Bild	DMNH10H028SCT-Teil
DMNH10H028SCT Preis	DMNH10H028SCT Hersteller	DMNH10H028SCT Bild	DMNH10H028SCT Aktie	DMNH10H028SCT Inventar
DMNH10H028SCT Neu	DMNH10H028SCT Original	DMNH10H028SCT garantiert	DMNH10H028SCT RFQ	DMNH10H028SCT Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited